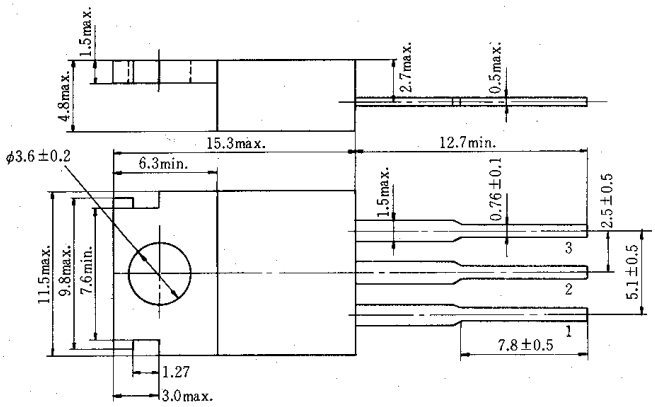
2SA755

シリコン PNP 三重拡散形
低周波電力増幅用
2SC1419とコンプリメンタリペア

SILICON PNP TRIPLE DIFFUSED
LOW FREQUENCY POWER AMPLIFIER
Complementary pair with 2SC1419



1. ベース：Base
2. コレクタ：Collector
（フランジ）(Flange)
3. エミッタ：Emitter
(Dimensions in mm)

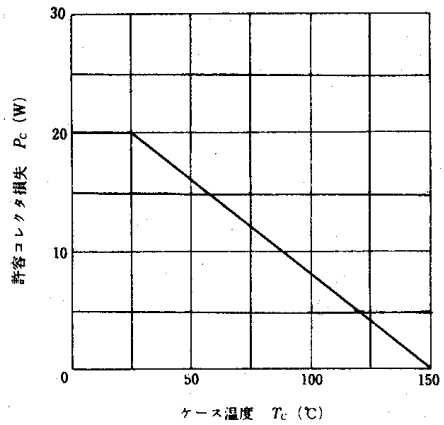
(JEDEC TO-220AB)

■絶対最大定格 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (Ta=25℃)

項目	Symbol	2SA755	Unit
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	−50	V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	−50	V
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	−4	V
コレクタ電流	I_C	−2	A
許容コレクタ損失	P_C *	20	W
接合部温度	T_j	150	℃
保存温度	T_{stg}	−55～+150	℃

* T_C=25℃における許容値
* Value at T_C=25℃

許容コレクタ損失のケース温度による変化
MAXIMUM COLLECTOR DISSIPATION CURVE



■電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta=25℃)

項目	Symbol	Test Condition	min	typ	max	Unit
コレクタ・ベース破壊電圧	$V_{(BR)CBO}$	I_C=−5mA, I_E=0	−50	−	−	V
コレクタ・エミッタ破壊電圧	$V_{(BR)CEO}$	I_C=−50mA, R_{BE}=∞	−50	−	−	V
エミッタ・ベース破壊電圧	$V_{(BR)EBO}$	I_E=−5mA, I_C=0	−4	−	−	V
コレクタ遮断電流	I_{CBO}	V_{CB}=−20V, I_E=0	−	−	−100	μA
直流電流増幅率	h_{FE}*	V_{CE}=−4V, I_C=−1A	35	−	200	
直流電流増幅率	h_{FE}	V_{CE}=−4V, I_C=−0.1A	35	−	−	
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	I_C=−1.5A, I_B=−0.15A	−	−	−1.3	V
ベース・エミッタ電圧	V_{BE}	V_{CE}=−4V, I_C=−1A	−	−0.9	−1.5	V
2次破壊電流	I_M**	V_{CE}=−30V, f=50Hz (half wave)	−2.0	−	−	A
利得帯域幅積	f_T	V_{CE}=−4V, I_C=−0.5A	−	50	−	MHz

*2SA755はh_{FE}の値により下記のように3区分し，現品に表示してあります。
*The 2AS755 is grouped by h_{FE} as follows.

Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ
35～70	60～120	100～200

** 2次破壊時における電流で定義される。
** I_M is defined as the current at which second breakdown occurs.